及溫度係數(Temp. coefficient.) 另poly電阻較Diff.電阻有較佳的線性度(linearity, Tcc.<100ppm/°C),較為電路採用。設計上會使用到各種不同尺寸的電 阻,製程的變異會造成元件實際尺寸與設計尺寸不同,特別是小尺寸的電阻, 同時在與外部金屬導線連接的區域,亦會貢獻大部分電阻,為使電阻值能精確 符合電路需要,必須建立完整的電路模型,如精確的  $Rs \cdot Rend \cdot \Delta W$  等

$$R = Rs \frac{L + \Delta L}{W + \Delta W} + 2 Rend$$

並分析其製程分布範圍, 匹配 (matching<0.5% for an area of 100um²), 溫 度係數(Temp. coif.) 電壓係數(voltage coif.) 以提供電路設計者參考。

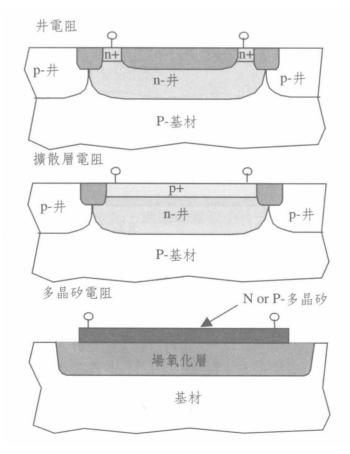


圖 10-17 CMOS 製程常用的電阻結構。